

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
27 janvier 2005 (27.01.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/008756 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 21/265, 21/762

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001826

(22) Date de dépôt international : 12 juillet 2004 (12.07.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03/08462 10 juillet 2003 (10.07.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES [FR/FR]; Parc Technologique des Fontaines,
Chemin des Franques, F-38190 Bernin (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **GHYSE-LEN, Bruno** [FR/FR]; 58, rue Georges Maeder, F-38170 Seyssinet-Pariset (FR). **AKATSU, Takeshi** [JP/FR]; 9, place de l'Eglise, F-38330 Saint-Nazaire-Les-Eymes (FR). **FONTANIERE, Richard** [FR/FR]; 26, avenue M. Peretto, F-38100 Grenoble (FR).

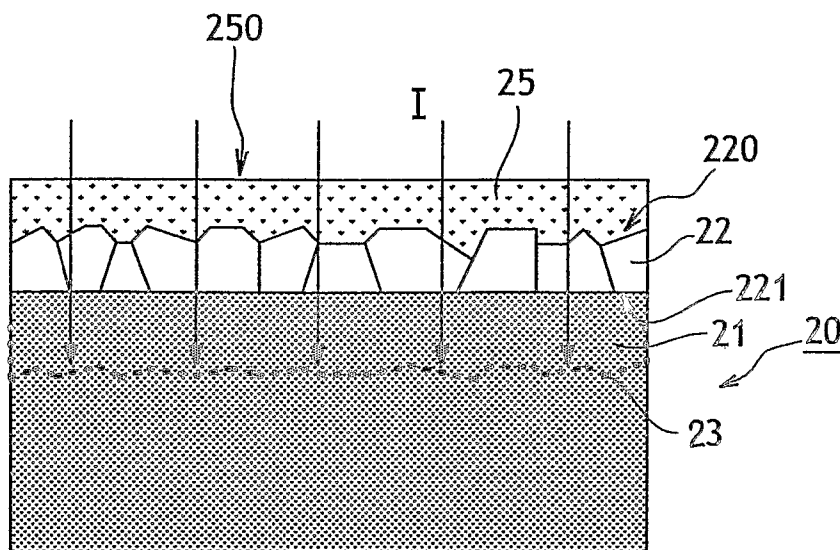
(74) Mandataires : **MARTIN, Jean-Jacques** etc.; Cabinet Regimbeau, 20, rue de Chazelles, F-75847 Paris Cedex 17 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR IMPLANTATION THROUGH AN IRREGULAR SURFACE

(54) Titre : PROCEDE D'IMPLANTATION AU TRAVERS D'UNE SURFACE IRRÉGULIERE



(57) Abstract: The invention relates to a method for implantation in a wafer comprising at least one layer having an irregular surface, whereby the implantation is performed through said irregular surface. The invention is characterised in that a coating step is performed prior to the implantation step, consisting in coating the irregular surface with a coating layer in order to increase the uniformity of the implantation depth.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé d'implantation dans une tranche comprenant au moins une couche présentant une surface irrégulière, ladite implantation traversant ladite surface irrégulière, caractérisé en ce que le procédé comprend préalablement à l'étape d'implantation une étape de recouvrement de ladite surface irrégulière par une couche de recouvrement, pour augmenter l'uniformité de la profondeur d'implantation.

WO 2005/008756 A1



KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

- *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement*

Publiée :

- *avec rapport de recherche internationale*
— *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues*

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.